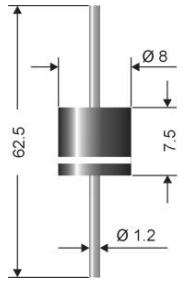
P 1000 A....P 1000 S



Axial lead diode

Standard silicon rectifier diodes

P 1000 A....P 1000 S

Forward Current: 10 A

Reverse Voltage: 50 to 1200 V

Features

- Max. solder temperature: 260°C
- Plastic material has UL classification 94V-0
- Max. junction temperature $T_j \leq$ 200°C in bypass mode

Mechanical Data

- Plastic case 8 x 7.5 [mm] / P-600 Style
- Weight approx.: 1.5 g
- Terminals: plated terminals solderable per MIL-STD-750
- Mounting position: any
- Standard packaging: 500 pieces per ammo

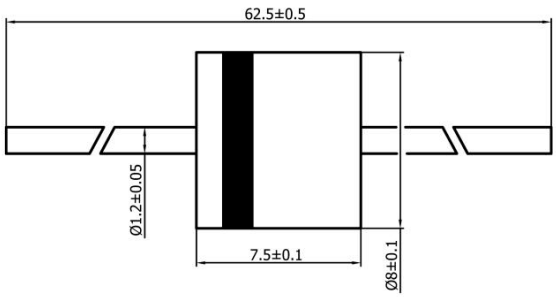
1) Valid, if leads are kept at T_A at a distance 10 mm from case
2) I_F = 5A, T_J = 25°C
3) T_A = 25°C
4) $R_{thT} \leq$ 5 K/W if leads are kept at ambient temperature at a distance 0 mm from case
5) Max. junction temperature $T_j \leq$200°C in bypass mode / DC forward mode

Type	Repetitive peak reverse voltage V_{RRM} V	Surge peak reverse voltage V_{RSM} V	Max. reverse recovery time I_F = - A I_R = - A I_{RR} = - A t_{rr} ns	Max. forward voltage V_F 2)
P 1000 A	50	50	-	0,9
P 1000 B	100	100	-	0,9
P 1000 D	200	200	-	0,9
P 1000 G	400	400	-	0,9
P 1000 J	600	600	-	0,9
P 1000 K	800	800	-	0,9
P 1000 M	1000	1000	-	0,9
P 1000 S	1200	1200	-	0,9

Absolute Maximum Ratings		T_A = 25 °C, unless otherwise specified	
Symbol	**Conditions**	**Values**	**Units**
I_{FAV}	Max. averaged fwd. current, R-load, T_A = 50 °C 1)	10	A
I_{FRM}	Repetitive peak forward current f > 15 Hz 1)	80	A
I_{FSM}	Peak forward surge current 50 Hz half sinus-wave 3)	400	A
i²t	Rating for fusing, t < 10 ms 3)	800	A²s
R_{thA}	Max. thermal resistance junction to ambient 1)		K/W
R_{thL}	Max. thermal resistance junction to terminals 4)	5	K/W
T_j	Operating junction temperature	-50...+175 ($T_j \leq$ 200°C in bypass mode 5))	°C
T_s	Storage temperature	-50...+175	°C

Characteristics		T_A = 25 °C, unless otherwise specified	
Symbol	**Conditions**	**Values**	**Units**
I_R	Maximum leakage current, T_j = 25 °C; V_R = V_{RRM}	<25	µA
	T_j = °C; V_R = V_{RRM}		
C_J	Typical junction capacitance (at MHz and applied reverse voltage of V)	-	pF
Q_{rr}	Reverse recovery charge (U_R = V; I_F = A; dI_F/dt = A/ms)	-	µC
E_{RSM}	Non repetitive peak reverse avalanche energy (I_R = mA; T_j = °C; inductive load switched off)	-	mJ

Dimensions in mm



case: 8 x 7,5 [mm]

 © by SEMIKRON

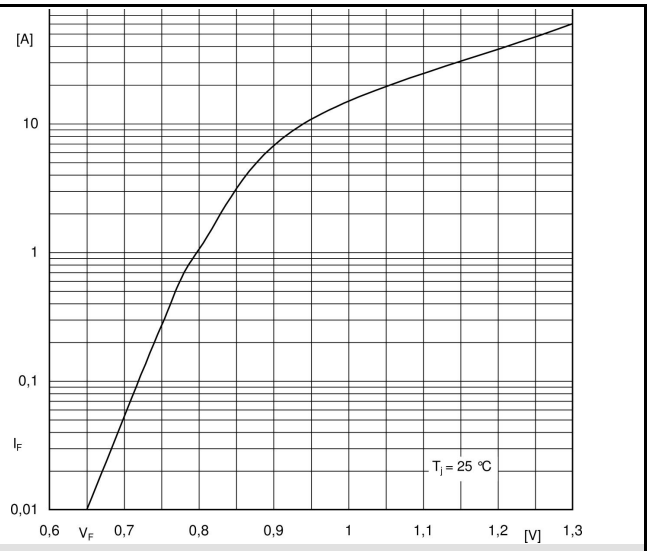


Fig. 1 Forward characteristic (typical values)

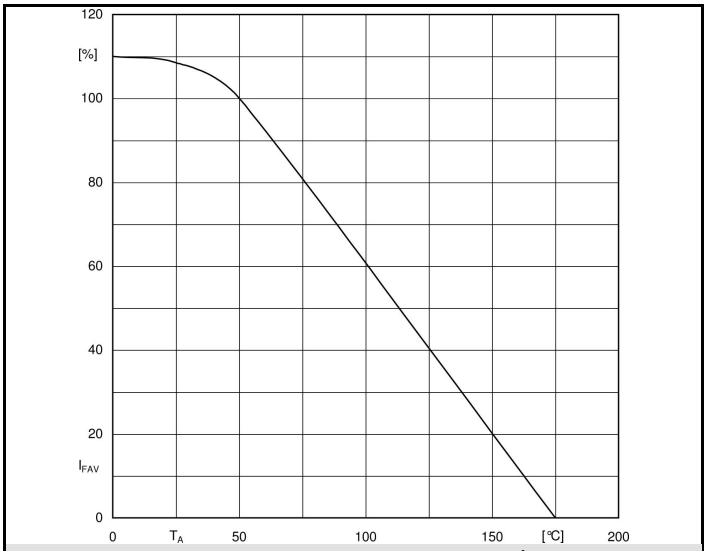


Fig. 2 Rated forward current vs. ambient temperature [1])

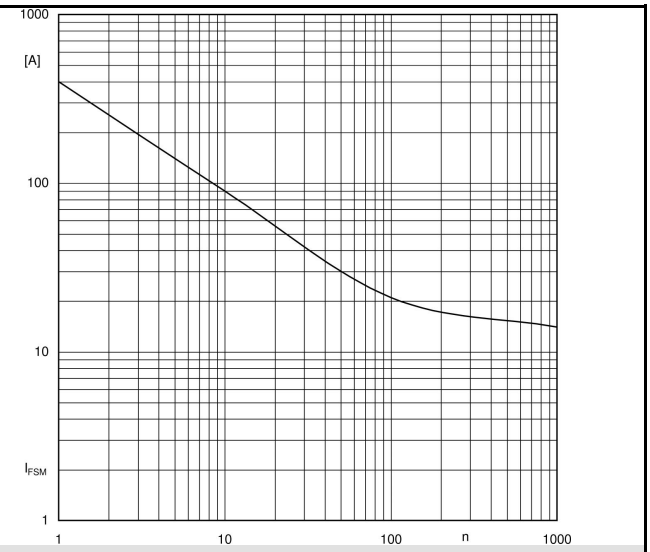


Fig. 3 I_{FSM} current versus number of cycles at 50 Hz

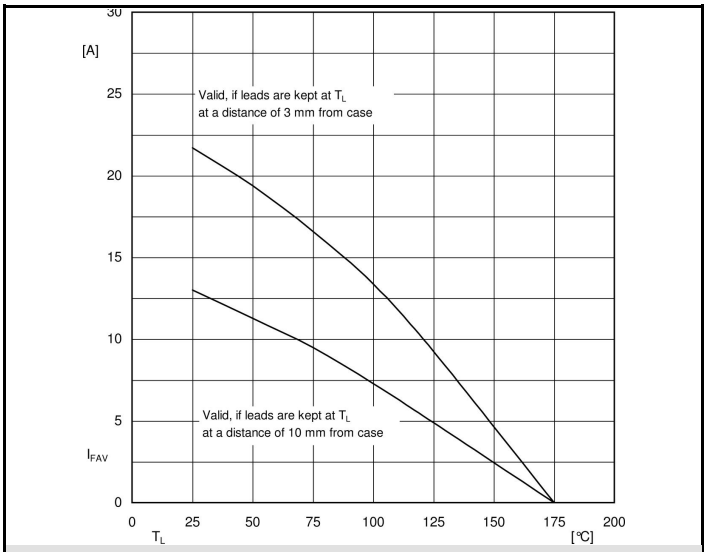


Fig. 4 Maximum Average Forward Current

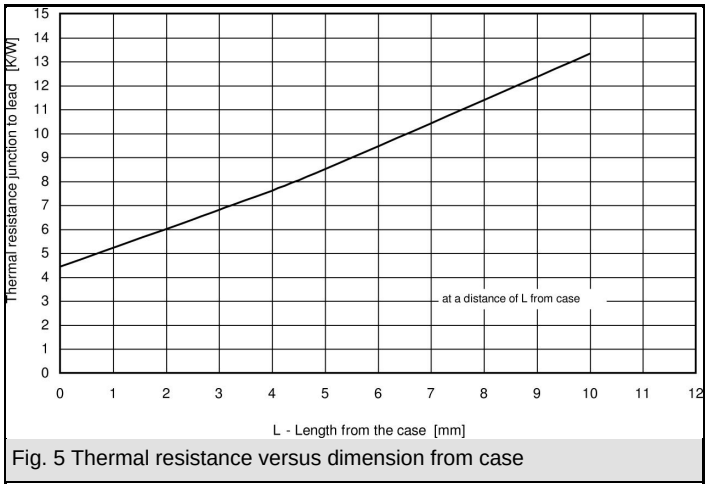


Fig. 5 Thermal resistance versus dimension from case

 © by SEMIKRON

ООО «НИОКРсистемс» - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование
- Работаем по 275 ФЗ

ООО «НИОКР СИТЕМС»
Москва, 125362, Россия, ул. Вишневая, д. 9, к. 1, Блок 104 а и 104 в

Телефон: 8 (495) 268-14-82
Email: n@nsistems.ru

ИНН: 7735154786
ОГРН: 1167746717709